
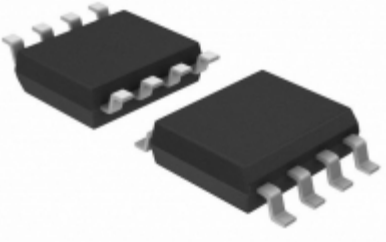
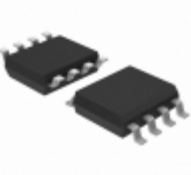


	<p>SI4116DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4116DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4116DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 111250 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4116DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	111250 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 18A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1925pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4116DY-T1-GE3CT

SI4116DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4116DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4116DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4116DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4116DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4120 VISHAY SI4120 VISHAY</p>	 <p>SI4116DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4116DY SI SI4116DY SI</p>
 <p>SI4120-KT Silicon Silicon TSSOP</p>	 <p>SI4122-BT Energy Micro (Silicon Labs) IC SYNTHESIZER RF2/IF 24TSSOP</p>	 <p>SI4116DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4115G-BM Energy Micro (Silicon Labs) FREQUENCY GSM/GPRS SYNTH EXT</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI4100DY-T1-E3	↔ SI4100DY-T1-E3	⇒ SI4100DY-T1-GE3	D SI4100DY-T1-GE3	↔ SI4102DY
↳ SI4102DY-T1-E3	⊛ SI4102DY-T1-E3	D SI4102DY-T1-GE3	⇒ SI4102DY-T1-GE3	↔ SI4104DY-T1-GE3
⊛ SI4104DY-T1-GE3	↳ SI4108DY-T1-GE3	⊛ SI4108DY-T1-GE3	↔ SI4110DY-T1-GE3	↔ SI4110DY-T1-GE3
D SI4112-D-GM	⊛ SI4113-BMR	↳ SI4114DY	⊛ SI4114DY-T1-E3	↔ SI4114DY-T1-E3
⇒ SI4114DY-T1-GE3	↔ SI4114DY-T1-GE3	⊛ SI4116DY	↳ SI4116DY-T1-E3	↔ SI4116DY-T1-E3
↔ SI4116DY-T1-GE3	⇒ SI4122-BTR	D SI4122-D-GMR	⊛ SI4122DY-T1-E3	↳ SI4122G-BMR
⊛ SI4123-BM	D SI4124DY-T1-E3	⇒ SI4124DY-T1-E3	↔ SI4124DY-T1-GE3	↔ SI4124DY-T1-GE3
↳ SI4126-BMR	⊛ SI4126DY-T1-E3	↔ SI4128BDY	⇒ SI4128BDY-T1-GE3	↔ SI4128BDY-T1-GE3
⊛ SI4128DY	↳ SI4128DY-T1	⊛ SI4128DY-T1-E3	D SI4128DY-T1-E3	↔ SI4128DY-T1-GE3
↔ SI4128DY-T1-GE3	⊛ SI4133-D-GM	↳ SI4133G-BT	⊛ SI4133T-BM	↔ SI4133T-BMR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited